【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成19年5月10日(2007.5.10)

【公開番号】特開2006-157624(P2006-157624A)
【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)
【年通号数】公開・登録公報2006-023
【出願番号】特願2004-346627(P2004-346627)
【国際特許分類】
Ｈ０４Ｎ　5/335　(2006.01)
Ｈ０４Ｎ　9/07　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/148　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０４Ｎ　5/335　Ｆ
Ｈ０４Ｎ　9/07　Ａ
Ｈ０１Ｌ　27/14　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成19年3月15日(2007.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
２次元表面を画定する半導体基板と、
前記半導体基板上に、２次元状に配列され、入射光量に応じた信号電荷を発生する多数個の光電変換素子と、
前記光電変換素子の列間に垂直方向に配列され、前記光電変換素子で発生した信号電荷を垂直方向に転送する垂直電荷転送手段と、
前記垂直電荷転送手段の端部に設置され、前記垂直電荷転送手段で転送された信号電荷を一時的に蓄積するラインメモリと、
前記ラインメモリに蓄積された信号電荷を選択的に読み出し、行方向の複数個ごとの信号電荷を加算して、行方向に順次転送する４相電極で構成される水平電荷転送装置と
を有する固体撮像装置。
【請求項２】
前記ラインメモリは、二層電極構造を有する請求項１記載の固体撮像装置。
【請求項３】
２次元表面を画定する半導体基板と、前記半導体基板上に、２次元状に配列され、入射光量に応じた信号電荷を発生する多数個の光電変換素子と、前記光電変換素子の列間に垂直方向に配列され、前記光電変換素子で発生した信号電荷を垂直方向に転送する垂直電荷転送手段と、前記垂直電荷転送手段の端部に設置され、前記垂直電荷転送手段で転送された信号電荷を一時的に蓄積するラインメモリと、前記ラインメモリに蓄積された信号電荷を選択的に読み出し、行方向の複数個ごとの信号電荷を加算して、行方向に順次転送する水平電荷転送装置とを有する固体撮像装置の駆動方法であって、
前記水平電荷転送装置は４相駆動であることを特徴とする固体撮像装置の駆動方法。